
窒素ガス無添加方式オゾンガス発生装置 ALD(原子層堆積法)の世界的な学会、ALD 2015に出展

東芝三菱電機産業システム株式会社(以下、TMEIC)(社長:町田 精孝)は、ALD(Atomic Layer Deposition:原子層堆積法)の世界的な学会であるALD2015(2015年6月29~7月1日、米国ポートランド ヒルトンホテル)をプラチナスポンサーとしてサポートし、併設の展示会では、主に半導体製造分野向けに販売しております「窒素ガス無添加方式オゾンガス発生装置」を出展いたします。

LSI やメモリなどの半導体は高集積化、大容量化が急速に進んでおり、半導体の製造では、より微細なパターンや、三次元構造に対応したプロセスへの要求がますます高まっています。ALD は原子レベルの膜厚制御を可能にする技術として注目され、半導体の高集積化・大容量化に貢献しています。

TMEIC が製造販売する「窒素ガス無添加方式オゾンガス発生装置」は、ALD プロセスにおいて酸化剤の供給装置として使用され、ガス中の不純物を極限まで抑制した成膜を可能にします。膜厚均一性に優れ、欠陥やピンホールのない緻密な膜を高速に成膜することが要求される ALD プロセスに欠かせない装置となっています。世界中の半導体工場のみならず、最先端の研究機関・大学などでも、超高濃度で窒素などの不純物を含まないクリーンなオゾンガスの製造装置として、600 台以上の稼働実績があります。

ALD プロセスは半導体製造にとどまらず、太陽電池パネル、バッテリー、バイオ MEMS(Micro Electro Mechanical Systems)など、その適用分野はますます拡大しています。

TMEIC は、クリーンで高濃度のオゾンガスをご提供することにより、ALD 技術の発展に貢献していきます。

■ALD 国際学会について

この国際学会は、American Vacuum Society の Thin Film Division が 2001 年から毎年主催しており、今回で 15 回目となります。(http://www2.avs.org/conferences/ALD/2015/index.html)4 年に一度、アジア地区で開催することになっており、昨年初めて日本で開催されました。

2014 年の本学会への参加者は623名、論文投稿件数は318件で、年々増加しています。

■ALD 技術について

ALD は Atomic Layer Deposition(原子層堆積法)の略で、原料ガスと反応ガスを交互に供給することにより 原子層成長を繰り返す薄膜作製手法です。

原子層を 1 層ずつ積み上げていくため、膜厚分布や組成が均一な膜を生成することができ、CMOS トランジスタの高誘電率ゲート絶縁膜や DRAM メモリキャパシタ絶縁膜形成などに実用化されています。

報道関係からのお問い合わせ先

東芝三菱電機産業システム株式会社 事業開発・広報部

〒104-0031 東京都中央区京橋3-1-1 東京スクエアガーデン Tel: 03-3277-4645 Fax: 03-3277-4578

TMEIC(ティーマイク)は、社会を支える基盤である「ものづくり」の現場ニーズにお応えするために、社会の発展と美しい地球環境とを調和させる産業システムインテグレータとして、「産業」「社会」「環境」の未来を常に見据えています。工場・プラントにおいて原動力となっている回転機、電力を変換・制御するパワーエレクトロニクス、そしてプラント全体を計画し実現するエンジニアリング、これらの技術をコアに、ものづくりと環境マネジメントに最先端の技術で貢献していきます。